

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

- Попков А.Ф., Кулагин Н.Е., Демин Г.Д., Звездин К.А.* Полевые особенности микроволновой чувствительности спинового диода при наличии тока смещения..... 109

Материалы электроники

- Неустроев С.А.* Моделирование орбиталей в тетраэдре кристалла кубического углерода..... 120
- Алексеев А.В., Лебедев Е.А., Гаврилин И.М., Кицюк Е.П., Рязанов Р.М., Дудин А.А., Полохин А.А., Громов Д.Г.* Влияние функционализации углеродных нанотрубок в плазме на процесс формирования электродного композитного материала УНТ – оксид никеля.. 128

Технологические процессы и маршруты

- Новак А.В., Новак В.Р., Дедкова А.А., Гусев Е.Э.* Зависимость механических напряжений в пленках нитрида кремния от режимов плазмохимического осаждения 138

Схемотехника и проектирование

- Старых А.А., Ковалев А.В.* Метод построения индикаторов длительности переходных процессов на основе формирователя коротких импульсов в асинхронных сумматорах 147

Элементы интегральной электроники

- Юсипова Ю.А.* Иерархия моделей работы ячейки магниторезистивной памяти с продольной анизотропией слоев кобальта..... 156

Королёв М.А., Павлюк М.И., Девликанова С.С. Физическая модель полевого датчика Холла на основе КНИ-структуры 166

Лалин А.Е., Парменов Ю.А. Влияние квантования носителей в поликремниевом затворе на сдвиг порогового напряжения МДП-транзистора 171

Биомедицинская электроника

Терещенко С.А., Лысенко А.Ю. Коррекция геометрического ослабления излучения в позитронно-эмиссионной томографии 180

Краткие сообщения

Семаков В.П. Алгоритм кластеризации ключевых точек на изображениях ИК-диапазона 187

Голишников А.А., Путря М.Г., Шабанов А.А. Исследование процесса анизотропного плазменного травления пассивирующих слоев $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-SiO}_2$ в условиях низкой полимеризации 191

Конференции

2-й Международный форум по электронно-лучевым технологиям для микроэлектроники – «Техноюнити – ЭЛТМ 2017» (9–12 октября 2017 г.)..... 3 стр. обложки

К сведению авторов 195